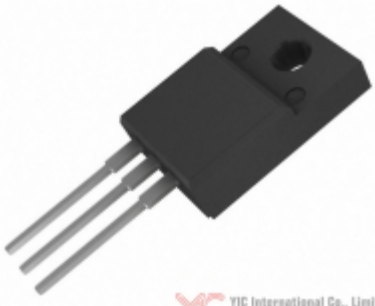



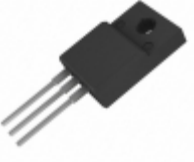



	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHF12N60E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 12A TO220 FULLP</p>
	<p>Datenblätter:  SIHF12N60E-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF12N60E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO220 FULLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	E
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	937pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®

SIHF12N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHF12N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF12N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHF12N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHF12N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO220 FULLP</p>	 <p>SIHF12N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 12A TO-220</p>	 <p>SIHF12N60E-GE3 Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 600V 12A TO220 FULLP</p>	 <p>SIHF12N65E V SIHF12N65E V</p>
 <p>SIHF15N60E VISHAY SIHF15N60E VISHAY</p>	 <p>SIHF12N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO220 FULLP</p>	 <p>SIHF12N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO220 FULLP</p>	 <p>SIHF12N60E TK12A60 Toshiba Semiconductor and Storage SIHF12N60E TK12A60 TOSHIBA</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SIHB12N65E	↔ SIHB15N50E	⇒ SIHB15N60E-GE3	D SIHB15N60E-GE3	⇒ SIHB15N65E
⊣ SIHB16N50C	⊗ SIHB16N50CTR-E3	D SIHB18N60E	⇒ SIHB33N60E-GE3	⇒ SIHB33N60E-GE3
⊗ SIHD3N50D-GE3	⊣ SIHD3N50D-GE3	⊗ SIHD7N60E-GE3	↔ SIHD7N60E-GE3	⇒ SIHF10N40D
D SIHF10N40D-E3	⊗ SIHF10N40D-E3	⊣ SIHF12N50C	⊗ SIHF12N50C-E3	⇒ SIHF12N50C-E3
⇒ SIHF12N60E	↔ SIHF12N60E-E3	⊗ SIHF12N60E-E3	⊣ SIHF12N60E-GE3	⇒ SIHF12N60E-GE3
↔ SIHF12N65E	⇒ SIHF15N60E	D SIHF15N60E-E3	⊗ SIHF15N60E-E3	⊣ SIHF15N60E-EG3
⊗ SIHF15N60E-GE3	D SIHF15N60E-GE3	⇒ SIHF16N50C	↔ SIHF16N50C-E3	⇒ SIHF16N50C-E3
⊣ SIHF18N50C-E3	⊗ SIHF18N50C-E3	↔ SIHF18N50D	⇒ SIHF18N50D-E3	⇒ SIHF18N50D-E3
⊗ SIHF22N65E-GE3	⊣ SIHF22N65E-GE3	⊗ SIHF510S	D SIHF520S	⇒ SIHF530S
↔ SIHF540S	⊗ SIHF5N50D	⊣ SIHF5N50D-E3	⊗ SIHF5N50D-E3	⇒ SIHF610S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited